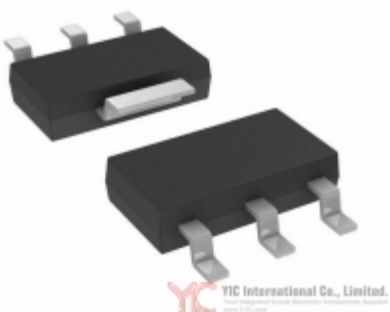


	<h2 style="color: red;">FDT86102LZ</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDT86102LZ</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 6.6A SOT-223</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FDT86102LZ.pdf</a> <a href="#">2.FDT86102LZ.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 20120 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDT86102LZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 6.6A SOT-223
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	20120 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	25 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 6.6A (Ta) 2.2W (Ta) Surface Mount
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	28 mOhm @ 6.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1490pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDT86102LZFSCT

FDT86102LZ ist neu im Original, Suche FDT86102LZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDT86102LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDT86102LZ: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDT86244</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2.8A SOT-223</p>	 <p><b>FDT86102LZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6.6A SOT-223</p>	 <p><b>FDT86106LZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.2A SOT-223-4</p>	 <p><b>FDT86113LZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.3A SOT223</p>
 <p><b>FDT55AN06LA0</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 12.1A SOT223-4</p>	 <p><b>FDT86106LZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.2A SOT-223-4</p>	 <p><b>FDT86113LZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.3A SOT223</p>	 <p><b>FDT55AN06LA0</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 12.1A SOT223-4</p>

heiße Teile

Mehr

➊ 1210ZC152JAT2A	➋ ADUM1310BRWZ	➌ BCM35243KFEB1G	D BZV55-C27	➍ CM2576-3.3
➎ CP1SA-24V	➏ CPV366MN	D EM24LC02	➐ EMIF03-SIM02F2	➑ FDT1600N10ALZ
➒ FDT1600N10ALZ	➓ FDT3N40TF	➑ FDT3N40TF	➋ FDT434P-NL	➌ FDT439N-NL
D FDT458P-NL	➑ FDT55AN06LA0	➒ FDT55AN06LA0	➑ FDT86102LZ	➒ FDT86106LZ
➓ FDT86106LZ	➓ FDT86113LZ	➑ FDT86113LZ	➒ FDT86244	➓ FDT86244
➓ FDT86246	➓ FDT86246	D FDT86246L	➑ FDT86246L	➒ FDT86256
➑ FDT86256	D FDY3000NZ	➓ GRM1885C2A3R7CA01D	➓ IS43R16320D-6BI-TR	➓ LM4041CEM3-ADJ
➒ LNK417LG	➑ LTC2864CS-1#PBF	➓ MAX4052CPE	➓ MMDF2N05ZR2G	➓ MP5021GQV-Z
➑ NAU8220WG	➒ P4SMA27R2	➑ PZM3.6NB2A	D R6007ENX	➓ RJK0346DPA
➓ SKKT131/18E	➑ SSM3J113TU	➒ TPS54229EDDAR	➑ V48A12M500A	➓ VE-2TD-05

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

